EDB101S-EDB106S

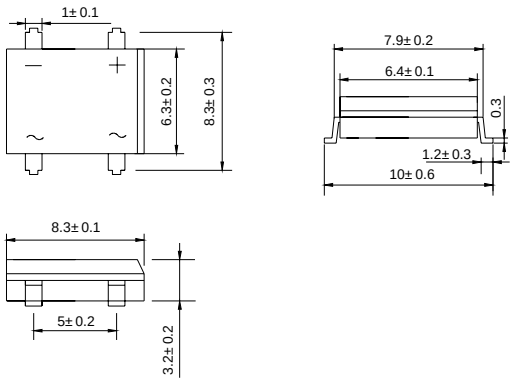
Silicon Bridge Rectifiers

VOLTAGE RANGE: 50 --- 400 V
CURRENT: 1.0 A

Features

- ◇ Rating to 400 V PRV
- ◇ Surge overload rating to 30 Amperes peak
- ◇ Ideal for printed circuit board
- ◇ Reliable low cost construction utilizing molded
- ◇ Lead solderable per MIL-STD-202 method 208
- ◇ Lead: silver plated copper, solderde plated
- ◇ Plastic material has UL flammability classification 94V-O
- ◇ Polarity symbols molded on body
- ◇ Weight: 1.0 grams

DB-S



Dimensions in millimeters

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase,half wave,60 Hz,resistive or inductive load. For capacitive load,derate by 20%.

		EDB 101S	EDB 102S	EDB 103S	EDB 104S	EDB 105S	EDB 106S	UNITS
Maximum recurrent peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	300	400	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	210	280	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	300	400	V
Maximum average forw ard Output current @T_A=55℃	$I_{F(AV)}$	1.0						A
Peak forw ard surge current 8.3ms single half-sine-w ave superimposed on rated load	I_{FSM}	30.0						A
Maximum instantaneous forw ard voltage at 1.0 A	V_F	1.0						V
Maximum reverse current @T_A=25℃	I_R	10.0						μA
at rated DC blocking voltage @T_A=100℃		1.0						mA
Maximum reverse recovery time (NOTE 1)	t_{rr}	50						nS
Typical junction calacitance (NOTE 2)	C_J	15				10		pF
Operating junction temperature range	T_J	- 55 ---- + 150						℃
Storage temperature range	T_{STG}	- 55 ---- + 150						℃

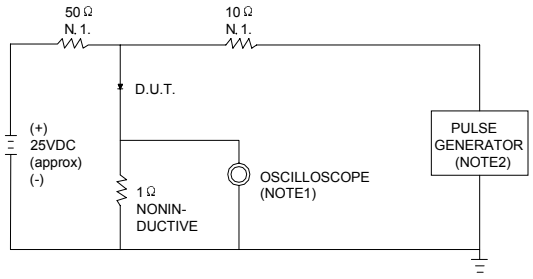
NOTE: 1. Test conditions: I_F=0.5A, I_R=-1.0A, I_{RR}=-0.25A.
2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

EDB101S-EDB106S

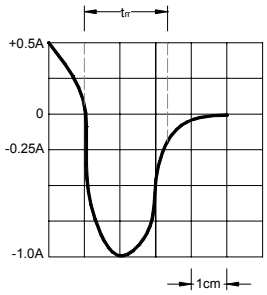
Silicon Bridge Rectifiers

Ratings AND Charactieristic Curves

FIG.1 -- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC

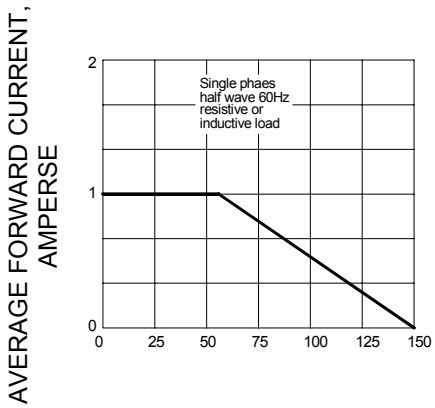


NOTES:1.RISE TIME =7ns MAX. INPUT IMPEDANCE=1MΩ.22pF
2.RISE TIME=10ns MAX. SOURCE IMPEDANCE=50Ω



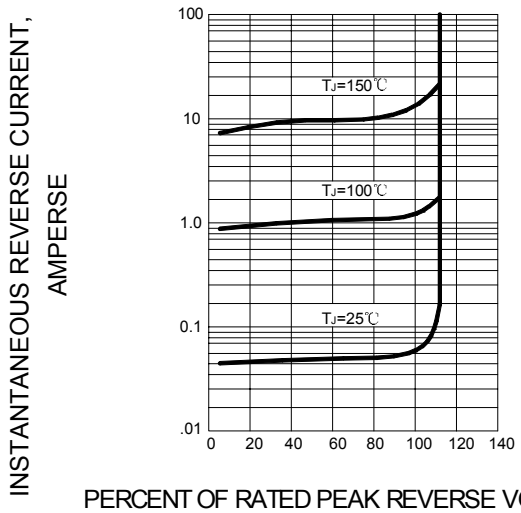
SET TIME BASE FOR
10 ns /cm

FIG.2 -- TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE



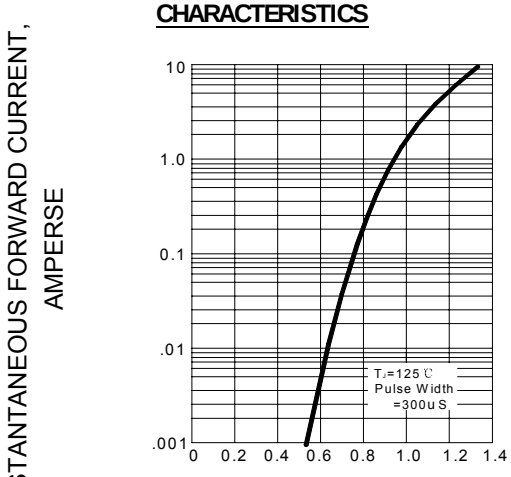
AMBIENT TEMPERATURE (℃)

FIG.3 -- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



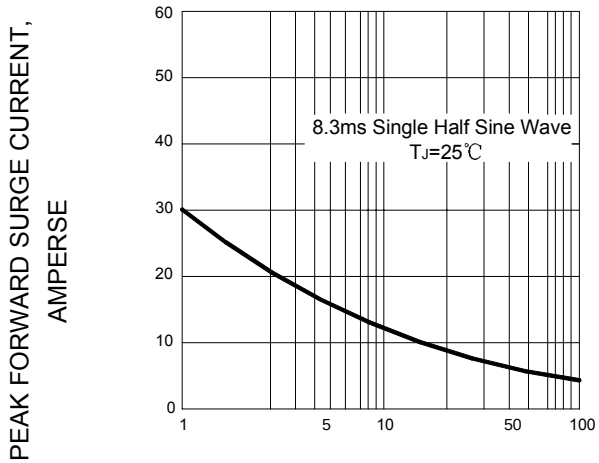
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)

FIG.4 -- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS



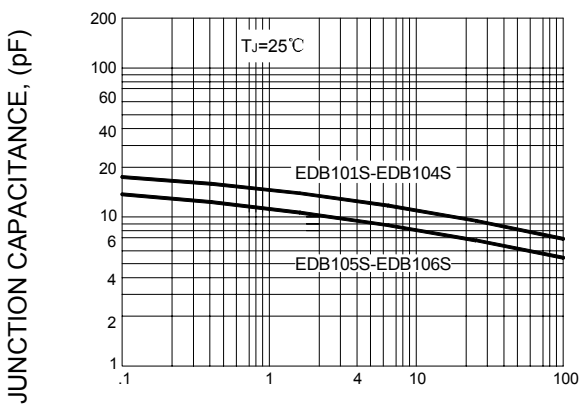
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS

FIG.5 -- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT



NUMBER OF CYCLES AT 60Hz

FIG.6 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



REVERSE VOLTAGE, VOLTS

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9